

تمرین سری هفتم - اصول ادوات حالت جامد - موعد تحویل ۱۰ اردیبهشت - تحویل ستاره دارها (*) الزامی نیست

۱. الکترواستاتیک دیود

برای یک اتصال pn پلهای سیلیکانی در دمای اتاق و با $N_D = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ و $N_A = 5 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$. محاسبه کنید:

(الف) ولتاژ ذاتی دیود V_{bi} . ب) عرض ناحیه تخلیه W در بایاس صفر و ۵ ولت معکوس. ج) بیشینه میدان الکتریکی E_{max} در بایاس صفر و ۵ ولت معکوس.

(د) نوارهای انرژی، چگالی بار، میدان الکتریکی و پتانسیل را بر حسب مکان در بایاس صفر و ۵ ولت معکوس رسم کنید.

(ه) فرض کنید $N_D = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ و $N_A = 5 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$. مقادیر خواسته شده در الف تا ج را برای این دیود محاسبه و با مقادیر قبلی مقایسه کنید.

۲. الکترواستاتیک دیود خطی

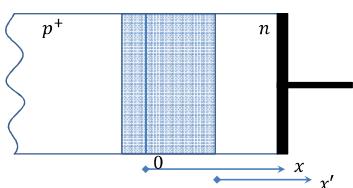
برای یک اتصال pn غیرپلهای سیلیکانی با پروفایل ناخالصی خطی در سمت n مطابق $N_D = ax$ (که در آن $a = 10^{20} \text{ cm}^{-4}$) و ناخالصی یکنواخت در

سمت p مطابق $N_A = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ میباشد. فرض کنید دیود تحت تاثیر ولتاژ V_A قرار گرفته.

(الف) اگر بدانیم $x_p = 0.5 \mu\text{m}$ است، x_n و عرض ناحیه تخلیه (W) چقدر است؟ ب) افت ولتاژ دوسر ناحیه تخلیه ($V_{bi} - V_A$) چقدر است؟ چه مقدار آن

در ناحیه p (بین $x_p - 0$) و چه مقدار آن در ناحیه n (بین ۰ و x_n) است؟ ج) بیشینه میدان الکتریکی E_{max} چقدر است؟ د) اگر سطح مقطع دیود

$100 \mu\text{m}^2$ باشد، این اتصال در این بایاس چه خازنی دارد؟



۳. دیود پایه کوتاه

در دیود ایدهآل مطرح شده در کلاس فرض شد که عمق نواحی n و p به مراتب از L_p و L_n بزرگتر است. حال دیود

n-p+ ای را در نظر بگیرید که در آن عمق ناحیه n قابل مقایسه با (و یا کمتر از) L_p میباشد. فرض کنید اتصال

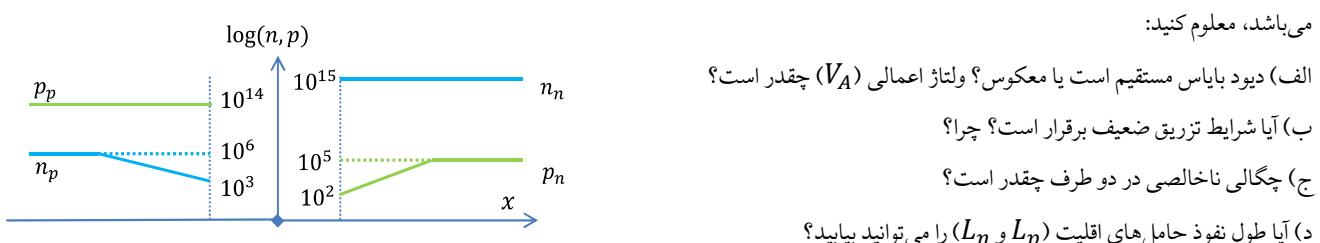
اهمی پایه n به نحوی است که همواره $\Delta p_n(x = x_b) = 0$.

(الف) با حل معادله پیوستگی Δp_n را درون ناحیه n بدست آورید و به کمک آن معادلات جریان-ولتاژ دیود پایه کوتاه را بدست آورید.

(ب) معادلات کنترل بار را مشابه آنچه در کلاس برای دیود پایه بلند نوشتمیم، بنویسید و نشان دهید که جریان نفوذ حفره‌ها در لبه ناحیه تخلیه برابر $I_p = Q_p / \tau_p$ است، که در آن $\tau_p = x_b'^2 / 2D_p$

۴. توزیع حامل‌های اقلیت

چگالی حامل‌ها در دیود سیلیکانی پلهای در دمای اتاق مطابق شکل رو برو است. اگر بدانیم طول عمر حامل‌های اقلیت $\tau_n = 10^{-8} \text{ sec}$ و $\tau_p = 10^{-7} \text{ sec}$ میباشد، معلوم کنید:



(الف) دیود بایاس مستقیم است یا معکوس؟ ولتاژ اعمالی (V_A) چقدر است؟

(ب) آیا شرایط تزریق ضعیف برقرار است؟ چرا؟

(ج) چگالی ناخالصی در دو طرف چقدر است؟

(د) آیا طول نفوذ حامل‌های اقلیت (L_n و L_p) را میتوانید بیابید؟

۵. توزیع حامل‌های اقلیت

چگالی حفره‌ها در سمت n یک اتصال n-p+ پلهای در دمای اتاق لحظه‌ای خاص مطابق شکل رو برو است:

(الف) آیا بایاس مستقیم است یا معکوس؟ چرا؟ ب) اگر $p_{n0} = 10^3 \text{ cm}^{-3}$ ولتاژ اعمالی چقدر است؟

(ج) چه جریانی (مستقیم یا معکوس) از دیود میگذرد؟ اندازه جریان را با فرض

$A = 10^{-4} \text{ cm}^2$ و $\tau_p = 10^{-7} \text{ s}$ بدست آورید.

